

а 2018 0065

Изобретение относится к способам получения полупроводниковых материалов и может быть использовано в полупроводниковой технике.

Способ, согласно изобретению, состоит в спекании порошка ZnO методом химической транспортной реакции в закрытом объеме при температуре спекания 900...1150°C. В качестве транспортных агентов используют HCl с начальным давлением 1...6 атм, водород с начальным давлением 50...200% от давления HCl и углерод в количестве, необходимом для выполнения условия  $C:HCl=0...1$  моль.

П. формулы: 1

Фиг.: 2